

LNA2904L

GaAs Infrared Light Emitting Diode

For optical control systems

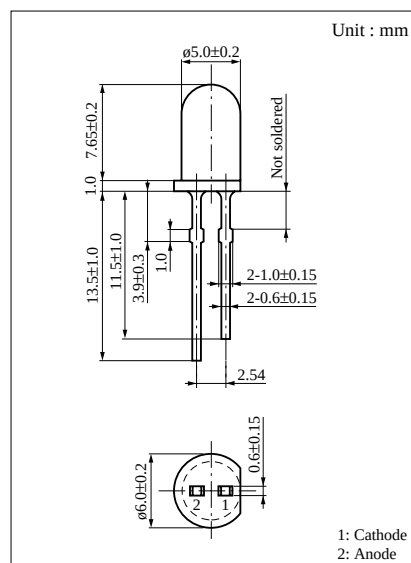
■ Features

- High-power output, high-efficiency : $I_e = 10 \text{ mW/sr (min.)}$
- Emitted light spectrum suited for silicon photodetectors
- Good radiant power output linearity with respect to input current
- High center radiant intensity
- Transparent epoxy resin package

■ Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

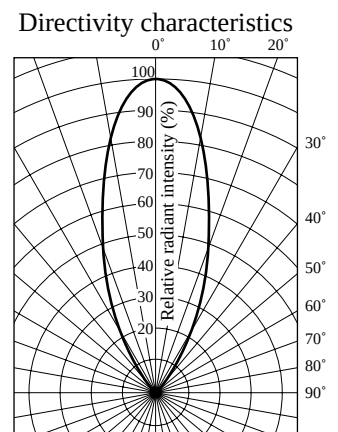
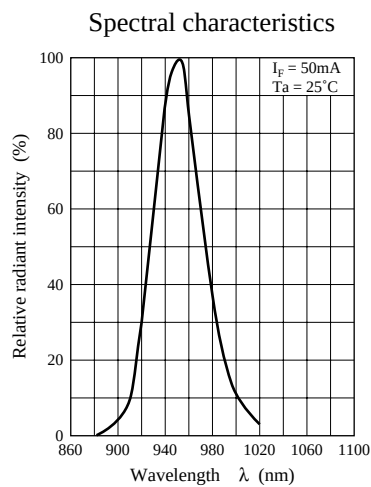
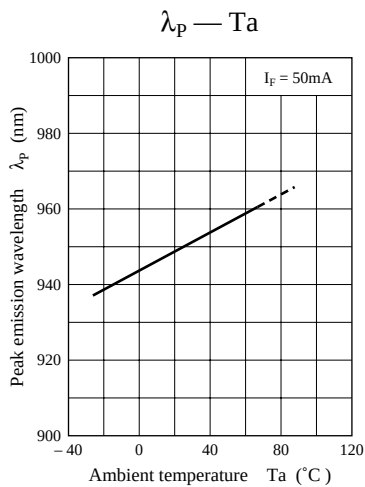
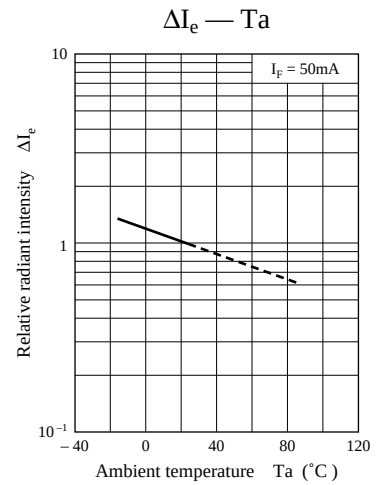
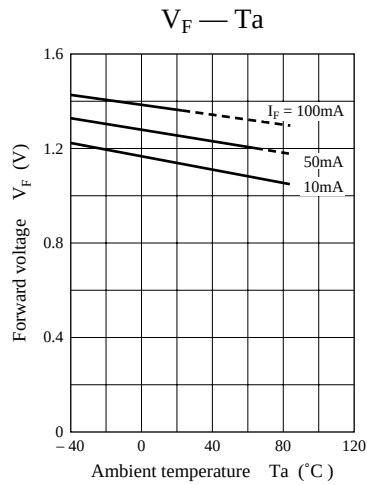
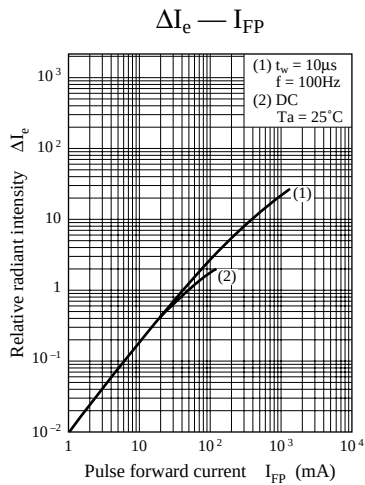
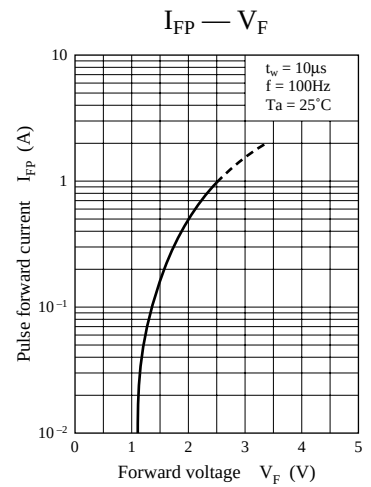
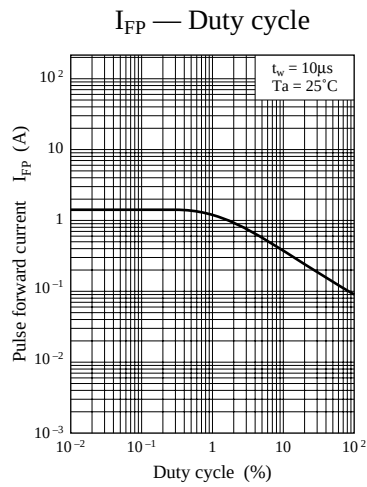
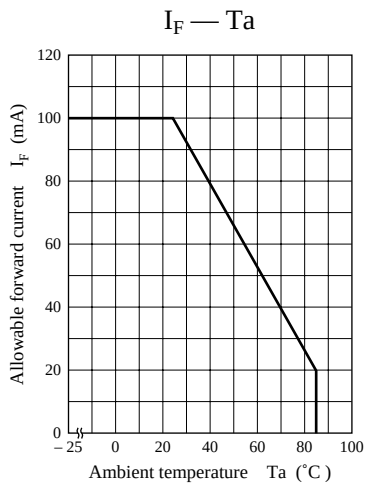
Parameter	Symbol	Ratings	Unit
Power dissipation	P_D	160	mW
Forward current (DC)	I_F	100	mA
Pulse forward current	I_{FP}^*	1.5	A
Reverse voltage (DC)	V_R	3	V
Operating ambient temperature	T_{opr}	-25 to +85	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-40 to +100	$^\circ\text{C}$

* $f = 100 \text{ Hz}$, Duty cycle = 0.1 %



■ Electro-Optical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Conditions	min	typ	max	Unit
Center radiant intensity	I_e	$I_F = 50\text{mA}$	10			mW/sr
Peak emission wavelength	λ_p	$I_F = 50\text{mA}$		950		nm
Spectral half band width	$\Delta\lambda$	$I_F = 50\text{mA}$		50		nm
Forward voltage (DC)	V_F	$I_F = 100\text{mA}$		1.35	1.6	V
Reverse current (DC)	I_R	$V_R = 3\text{V}$			10	μA
Capacitance between pins	C_t	$V_R = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		50		pF
Half-power angle	θ	The angle in which radiant intensity is 50%		20		deg.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9